Облікова картка ДіР

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0207U008721

Державний реєстраційний номер: 0106U001337

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 19-12-2007

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Дослідження низькотемпературних характеристик напівпровідникових мікрокристалів і структур в полях ефективного зовнішнього впливу для створення сенсорів

Початок етапу: 01.2006

Закінчення етапу: 12.2007

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 744300

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський Політехнічний Інститут"

Код за ЄДРПОУ: 00027677

Місцезнаходження: пр. Перемоги 37, м. Київ, Київ, 03056, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 0442048428

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Дослідження низькотемпературних характеристик напівпровідникових мікрокристалів і структур в полях ефективного зовнішнього впливу для створення сенсорів

Назва роботи англійською:

Study of low temperature characteristics of semiconductor microcrystals and structures in the fields of the effective external influence for sensors creation

Реферат українською:

Проведено теоретичні та експериментальні дослідження низькотемпературних характеристик напівпровідникових мікрокристалів (кремній, германій і їх тверді розчини Si-Ge) та шарів полікремнію на ізоляторі (КНІ-структур) в полях ефективного зовнішнього впливу. Створено п'єзорезистивні сенсори механічних величин і сенсори теплових величин на їх основі з цифровою обробкою вихідного сигналу.

Реферат англійською:

Theoretical and experimental studies of low temperature characteristics of semiconductor microcrystals (silicon, germanium and Si-Ge solid solutions) and polysilicon on insulator layers (SOI-structures) in the fields of the effective external influence were carried out. Mechanical piezoresistive sensors and thermal sensors with digital output signal processing are created on their basis.

Індекс УДК: 681.121./123; 532.57, 531.797

Коди тематичних рубрик: 59.37.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін Анатолій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Піх Зорян Григорович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

